6. 角度分解紫外光電子分光法による CaF₂/Si(111)1×1 表面の研究

大 貫 等

Si(111)表面に CaF_2 を 1 分子層エピキタキシアル成長させて、 $CaF_2/Si(111)1 \times 1$ 表面を作成した。角度分解紫外光電子分光法により表面電子状態のエネルギー分散関係を求めた。分散関係は界面 F 層が消失した CaF モデルの理論計算と良く一致し、これは既に行なわれた光電子回折実験の結果とも矛盾しない。励起光の入射角依存性より表面電子状態は、Si ダングリングボンドと Ca4s を起源とすることが明らかにされた。

7. 角度分解紫外光電子分光法による Si $(111)\sqrt{3} \times \sqrt{3} - B$ 表面の研究

山 崎 悟

 HBO_2 源を用いて $Si(111)\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ -B 表面を作成し、ARUPS 測定を行なった。 2本の表面電子状態が観察され、分散幅、分散方向が他の $Si(111)\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ - \mathbb{I} 族(AI、 Ga、In)のそれと類似していることを見出した。これより $Si(111)\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ - B の表面構造として T_4 adatom model が支持された。

○筑波大学大学院物理学研究科物理学専攻

スピングラスの準安定状態-ナイーヴ平均場模型による解析- 西村 耕三
励起水分子の回転構造の研究 松本 隆宏
t-Jモデルの磁気的性質 橋本 佳三
Cu-V-O系の相転移 山崎 聡
Sr₂V₃O₉系の磁性と NMR 村松 正吾